### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-198022

(43)Date of publication of application: 16.08.1988

(51)Int.CI.

G02F 1/133

G09G 3/36

(21)Application number: 62-029657

7 (71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

13.02.1987

(72)Inventor: KISUMI SHINTAROU

HOSHIYA TAKAYUKI

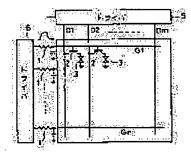
TAKAHARA KAZUHIRO

#### (54) ACTIVE MATRIX TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent generation of uneven display luminance by less steepening the rise of the scan pulses to be successively impressed to scan pass lines.

CONSTITUTION: Liquid crystal cells 3 are connected via switching elements 2 such as thin film transistors TFT to the intersected points of data bus lines D1WDm and the scan pass lines G1WGn. Data voltages are impressed from a driver 5 to the data bus lines D1WDm and the scan pulses are impressed from a driver 6 to the scan pass lines G1WGn via time constant means 1 for less steepening at least the rise of the scan pulses. Namely, the time constant means 1 consisting of resistors, capacitors, etc. to set at least the rising time constant t of the scan pulses to be impressed to the scan pass lines G1WGn at the time constant Rt.Cg or above of the process transferring from on to off of the switching elements 2 are provided, by which the change component between the liquid crystal cell voltage of a near point and the liquid crystal cell voltage of a distant point is made nearly the same. The generation of the uneven display luminance is thus prevented and the display quality is improved.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

大大,**没是**在大人,心态点,

The second second

最近行動の問題としている

工(物) 四美 題 四八

位配式公司有的支票 衛 一次的

[1877] A TOLLING TO TOP TO THE PARTY TO THE TOP TO THE TOP THE TOP TO THE TO 46.5

12 68 全国大组织中华。中国运用中央中央国南非市徽区的中西等 2.

过去这数据发展。 上表现的知识 上述,是这种严重的是几次性 ₹5 ## C

3.

1、1876日中国人社区市中北部区外公共中 · 第一字 第二章 至 第二章 A 48 27 1

As the second of the second of

13 3 13 B

with the first the second section is 医多克氏试验检尿病 化二甲基苯酚二甲基甲酚二甲基 数タがつ きょうじじょ とうしょりょくと

网络胡椒饼 一个茶碗产品人出了什么,每个个人

□記の事器基準スト トラミット **経済を研究のできる。** 

人名伊萨沙拉斯 "我就要'阿里一红老老行"了一个一个 アンド・スタン機能 みりゃく 政治・する (職員) うご けないい バス ジャストさげ 裏西さってきらい

医经产品 医艾森伊氏病 人名巴拉姆 医阿里氏腺 こうほぎいってが、強い流動は落まっている。 1、1947年,1947年,1988年中1947年,1947年

网络美国教育 医电子多位

SANGER BERRY TO SERVE OF SERVE

公でから マンヤー ひょうと 性が有用をしまする ROGERSON BREEKENSE - Post 在自己工作工具并在各类型中企業務分類。

と、マグラインを認知のは関本をよって 東西から

三部では発発病最多は大タイパー 響って

は縁なったが きび ピーチン マデエが動物 品·粮食(100) 整个十个大多种的食物或品或企业和企业的 "孩子我看着我们就有"我们"等众的过去。 人名格尔 医骨髓病 医生物

满腹野女鬼中一个 大家工作 化电池经济

The Control of the Co A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

and the first of the control of the second of the control of the control of the control of the control of the The second secon

#### 9日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

#### 砂公開特許公報(A)

昭63-198022

MInt Cl.4

識別記号

广内教理番号

母公開 昭和63年(1988) 8 月16日

G 02 F G 09 G 1/133 3/36

332

8708-2H 8621-5C

未請求 発明の数 1 (全7頁) 笨查請求

の発明の名称

- 12

アクティブマトリクス型液晶表示装置

创特 爾 昭62-29857

色出 顧 昭62(1987)2月13日

母 明 者 木 栖 饭 太 郎

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 宮土涌株式会社

内

内

勿発 明者 屋 星

之 绖

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

②発 朙 老 和

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

仍出 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

20代 理 人 弁理士 柏谷 阳司 外1名

#### 1 発明の名称

アクティブマトリクス型液晶変示強置

#### 2 特許請求の範囲

(i). データパスライン (DI~Dm) とスキャ ンパスライン(G1~Ga)との交点に、スイッ チング素子 (2) を介して液晶セル (3) を接続 したアクティブマトリクス型液晶表示装置に於い τ.

前記スキャンパスライン(Gl~Gn)に印加 するスキャンパルスの少なくとも立下り時定数を 、前記スイッチング杂子(2)のオンからオフに 移行する過程の時定数以上に設定する時定数手段 (1) を設けた

ことを特徴とするアクティブマトリクス型波晶 表示装置。

凶、前記時定数手段(1)は、前記スキャンパ スライン (Cl~Gn) と前記スキャンパルスを 出力するドライバとの間に接続した抵抗とコンデ ンサとの何れか一方或いは両方から構成されてい ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の アクティブマトリクス登波品表示装置。

四、前記時定数手段(1)は、ドライバの前記 スキャンパルスの立下りを制御するスイッチング 素子と直列に接続した抵抗から構成されているこ とを物位とする特許論求の範囲第1項記載のアク ティブマトリクス型液晶表示装置。

#### 3 発明の詳細な説明

#### (養養)

データ電圧をフレーム周期等の所定の周期年に・ 反転してデータバスラインに印加するアクティブ マトリクス型液晶製示装置に於いて、スキャンパ スラインに順次印加するスキャンパルスの立下り をなまらせることにより、ドライバからの遠近に 拘わらず、液晶セル電圧の変化分をほぼ同じくし て、表示輝度むらの発生を防止したものである。

#### (選集上の利用分野)

本発明は、表示品質を改善したアクティブマト リクス型波晶変示装置に関するものである。

アクティブマトリクス型液晶変示弦置は、スキ

#### 特開昭63-198022(2)

- 1 - 1 (後来の技術) v 1 4 2 2 2 6 2

アクティブマトリクス級被馬東示韓置は、直安 配図したスキャンペスラインとデークペスライン との交点に、スイッチング技子として原献トラン ジスタ (以下工足工と場合する) そ数け、このエ アモ介して放品をルを検索した構成が一般圧し あり、データペスラインに印加するデータ電圧は フレーを保に係性を反応し、ススキャンペスラ インにTFTをオンとする為のパルス電圧を順次 印加するものである。

第6回は従来例の動作製明図であり、スキャンパスラインに印加するパルス電圧は、例に示すように、TPTを立ひとする電圧Vgom といまつとでする電圧Vgomといまった。サントの配式とからなり、又デーク常圧は、M・に示すように、フレーの例打る等の所定の周別年の機種性が反転される。

は、近野性のデッタ電圧もV。4がデータバススラインに印放された時に、スキャンパスラインに印放された時に、スキャンパスラインの配圧 V いのが印放されたでドアがオンとなり、そのでは、これる。次にスキャンパスラインに電性をから、次にスキャンパスラインに電性をから、次の関連をでは、データ管圧の関連をでは、データ管圧の関連を表して、次の関連では、データ管圧の関連をある。そして、スキャンパスラインに電性が反転され、そして、スキャンパスラインに電性が反転され、そして、スキャンパスラインに電

EVaon が印加されると、被品セルには负額性のデークな圧・Vdが印加される。後って、液晶セル常圧は、第2回の向に示すように、関期的に極性が反転する。

第7関は歳品もルの接続機成態明限であり、T FT23のドレインがデータパスライン21に接続され、ゲートがスキャンパスライン22に接続され、ソースが液晶セル24に接続されている。 又液晶セル24の接地側は、共通パスラインに接続されている。 なお、CGはTET23のゲート 容量、CGは接続セル容量、Rはスキャンパスライン22の等価製施、Cは参価容量を示す。

第8図はTPTのオン、オフによる前作戦明図であり、(A)はTPT23をオン状態とした場合を示し、液晶をル容量Ccには、TPT23のゲート容量Cgを介してパルス電圧Vgeaが印加され、且つオン状態のTPT23を介してデータ電圧Vdが印加される。

又(B)はTFT23をオン状態からオフ状態 に終行させる場合を示し、パルス電圧をVgom か ら、V sollに変化させる道程に於けるT-FT 2.3 の 等価距抗をRiで示す。

以(c)は、ベルス電圧がVeoffとなって、T 正正を多が完全にオフ状態となった状態を、オフ 、状態のスイッチで示す。

。 TPボミスがオンからオフに移行することによ う、液晶セル電圧は、

AV C. C. C. C. S. (V soff - V son)

だけ変化する。これは、第6個の何に於けるAV に相当する。この変化分AVについて予めコモン 電圧Vc(第3個の何参照)を共過パスラインに 印加することにより補正して、液晶セル電圧の正 低性電圧と象価性電圧とが対称的となるように設 定されている。

(発明が解決しようとする問題点)

スキャンパスライン22の等価抵抗Rと等価容量Cとにより、ドライバから出力されてスキャンパスライン22に印度されたパルス電圧は、次第に波形が左まることになる。ドライバから近い位

#### 特別昭63-198022 (3)

置に於いては、ペルス電圧がVgoa からVgoffへ 急岐に立下るので、第8図の(A)のTFTオン 状態から、(C)のTFTオフ状態へ瞬時に移行 することになる。

しかし、ドライベから遠い位置に於いては、彼形のなおりにより立下りが設やかとなるから、第8図の(B)の過程を移由し、データ電圧Vdが抵抗Rtを介して被晶セル容量Ccに組織して加えられることになり、液晶ゼル電圧の立下がの時定数が、でドT23のゲート容量Csを充位する時度数Pt・Csより大きい場合、ベルズ電圧がVgoaからVgoffへ立下る過程に於いて、下下25の関位電圧Vthにベルス電圧が低下するまで、下下23は六ツ状態を提続することになり、その場合の液晶ゼル電圧の変化がムVkg、流流

AV TOCKFO CONTINUE TO A CONTIN

となる。Veor シV いかであるから、液晶セル電 圧の変化分AV>AV となり、近点の液晶ゼル に対して達点の波晶セルに負ける液晶セル電圧の 変化分は小さくなる。

第6図の何に於ける実線は、ドライバから違い 位置の被品セル電圧、点線はドライバから違い位 でがあるコモン電圧 V c により近点被品セル電 上を補正しても、違点被晶セル電圧を補正する。 とができなくなり、スキャンパスライン方向に必 とができなくなり、スキャンパスライン方向に必 った表示算度ならが空じると共に、正負額性の なんがある。

又TPT23の関値電圧Vthは、データ電圧 Vdに依存して変化するものであり、

で表すことができる。なおVIA。 EE依存じない関係で圧である。

使って、正確性データ電圧を印加した場合よう も、負担データ電圧を印加した時の関値電圧が 低くなり、液晶を心電圧の変化分 A V は、第6 因の回の点線で示すように、負性性データ電圧印

加盟間に扱いで特に示さくなり、これによっても 表示輝度むらが生じる。 (1950年) (2018年)

第9回の(A)。(B)は輝度むち発生の説明 図であり、機能は液晶をル電圧V、緩縮は透過光 又は反射光の強度Bを示す。又(A)は2値次示 の場合を示し、(B)はフルカデー(階間)変示 の場合を示す。2位表示の場合は、(A)に示す ように、風は関値以下の液晶をル電圧に適定し、 白は飽和関値以上の液晶をル電圧に適定し、 により、近点(点級の丸で示す)も違点(実験の た又は黒丸で示す)もほぼ同じ輝度で表示できる ように設定することができる。

これに対して、階調表示を行う場合は、「(B) に示すように、黒の関値と白の飽和関値との側の 液晶セル電圧を用いるものであり、遠点 (実験の丸) を白姿示とする場合に、飽和関値近傍の液晶セル電圧の実効値より大きい実効値となる。しかし、遠点 (馬丸) を基表示とする場合、その遠点の液晶セル電圧の実効値より大きい実効値となる

近点 (点線の丸) の輝度は白に近いものとなる。 使って、無表示を行う場合に、ドライベに近い個 の輝度が大きくなる輝度むらが生じ、表示品質を 劣化させることになる。

本発明は、資達のような解皮ならの発生を防止 して、表示品質を改善することを目的とするもの である。

#### 【問題点を解決するための手段】

本発明のアグディブマドリクス型複晶表示ススティブマドリクス型複晶を示える。 ・ 第1回を参展して戦勢すると、インローへの交点に、では、アータでは、データでは、アータでは、アータでは、アータでは、アータでは、アータでは、アータでは、アータでは、アータでは、アータでは、アータでは、アーターのアーターのアーターのオンからスキャング素子2のオンからオフに移行する。スキャング素子2のオンからオフに移行する。スキャング素子2のオンからオフに移行する。スキャング素子2のオンからオフに移行する。スキャング素子2のオンからオフに移行する。スキャング素子2のオンカースを表示のスティブティブを表示。

#### 特開昭63-198022 (4)

る通風の時定散以上に設定する抵抗等の時定数手。 限1を設けたものである。

#### (作用)

スキャンパスラインG1~Gnに印加するスキャンパルスの立下りを、時定数手段1によってなまらせることにより、ドライベ6に近い被晶セル3に接続されたスイッチング君子2も、オンからオフに歩行する時に、第8回の(B)の状態を経由することになり、近点の放品セル意圧との変化分をほぼ同じくすることがである。

ショングルローウル及みが(異異異)。でありたいほど

23 、以下回避免券屋上で赤銀男の家庭県をつかて井 3. 毎年集団する。 1人のお紹介を成まって、1年中

第1回は本発明の一裏推例のブロック図であり、 育道のように、データがスラインD1~Daと スキャンパスラインG1~Gaとの交点に、TP T等のスイッチング素子2を介して放品セル3を 機様し、データパスラインD1~Dmにドライバ 5からデータ管圧を印加し、スキャンパスライン GI~Gロにドライベ6からスキャンパルスの少なくとも立下りをなまらせる特定数手段 I を介してスキャンパルスを印加するもので、その手段として、ドライベ6とスキャンパスライン GI~G n との間に抵抗を接続した場合を示す。 又抵抗と共に点線で示すようにコンデンタを接続することもできる。

この実施例の場合は、スキャンパルスの立上りと立下りとの被影がなまることになるが、立下りがなまることになるが、立下りがなまることにより、ドライバ6に対して近点の被係セルに扱いても、スイッチング素子2がオンからオフに移行する時に、第8回の(B)の状態を延由することになり、その電圧の変化分が遠点の液晶セルと同様になる。

又個別素子としての低度の代わりに、ドライベ 6から近点のスイッチング素子 2に至るまでのス キャンパスライン G 1 ~ G n の個や厚さを小さく して、低度成分を大きくした時定数手段 1 を用い 。ることもできる。

第2回は本発明の他の実施例のドライバの原部

使为人 经现

国最関であり、リチナネルMOSトランジスクQ 1 とロチャネルMOSトランジスクQ2とを、時 定放手段としての抵抗R1を介して直列に接続し トランジスクQ1のソースをスチャンパスライ ンG1に接続する・

野り立な関心行動

使って、トランジスタQ1がオンとなって電圧 Vgon がスキャンパスラインG1に印加された時 の立上りは急遽となるが、このトランジスタQ1 がオフとなって、トランジスタQ2がオンとなり 、電圧VgoIIが抵抗R1を介してズキャンパスラ インG1に印加された時に、抵抗R1により立下 りがなまることになる。

第3 図は本発明の実施例の動作説明図であり、 のはデータ電圧で、フレーム周期等の所定の周期 毎に + V d と - V d とに極性が反転される。又の はスキャンパルスを示し、第1 図に示すように 流中コンデンサ等をドライバ 6 とスキャンパスラ インG 1 ~ G a との間に接続したことにより、立 上りと立下りとの波形がなまった場合を示す。又 何は波晶セル電圧を示し、 Δ V 」は正極性のデー タ電圧 + V d を印加した時の複晶セル電圧の変化 介。 A V z は負極性のデータ電圧 - V d を印加し た時の微晶セル電圧の変化分を示す。又は、はは 近点と違点とを対比してデータ電圧。スキャンパ ルス、液晶セル電圧を示し、A V = 1 A V = 1 は近 点の液晶セル電圧の正極性データ電圧と負極性デ - タ電圧とを印加した時に設ける変化分、A V = 1 に負極性データ電圧との印加した時に設ける変 化分を示す。

スキャンペルスの立上り及び立下りは、スキャンペルスの立上り及び立下りは、スキャンペスラインを伝鞭するに従って一層なまることになるが、遠点の液晶セルのスイッチング素子2に対して、なって、前島セルでは、第8図の(B)の状態を移行してスイッチング素子2は完全なオフ状態となる。そので、食品セル電圧の変化分は小さくなり、負債性デー

#### 特開昭63-198022 (5)

ク電圧を印加した場合に於いても、近点及び速点に於ける液晶セル電圧の変化分 $\Delta$  V  $_{zz}$ はほぼ間じく小さいものとなる。

このように、近点と遠点とに於ける被晶セル電 圧の変化分が小さくなると共に、ほぼ同じくなる から、輝度むらの発生を防止し、変示品質を向上 することができる。

第4因は彼形のなまりを栽明する為のスキャンパスラインの等質回路であり、近抗R、~R。をそれぞれ10 K 2 とし、分布容量で、~C。をそれぞれ10 p P として、出力インピーダンス50 2のベルス発生器 P G から5 V のベルスを印加した時、各点の~多に設ける時定数で(6 3 2 %に達する時間)を求めたところく第 5 固に示す結果が得られた。即ち、時定数では、 額定位置のでは 0.5 p S、多では 1.3 p S、のでは 2.5 p S、のでは 3.5 p S となった。

「又下ですがデンからオフに歩行する時の等価度 抗Rtは約10°Q、ゲート容量ででは約19P

经19分别 电电子磁圈放光管 法非关键 化弧霉化剂

であるから、その時定数R t・C g は約1 m S となる。従って、TPTをオンからオフに移行させる時の時定数が1 m S 以上あれば、液晶セル電圧の変化分は近点も途点もほぼ同じくなる。

第4回に扱いては、測定位置の、の間で1 a S 以上となるから、R . . C . をドライバ6 とスキ ・ンパスラインG 1 ~ G a との固に接続した低抗 及びコンデンタとからなる時定数子改良とすれば、 をれば彼の各位のでは時定数子が1 a S以上 であるので、数値を必定であることができませない。 なり、健康ならの完全を防止することができませない。 なり、健康などのの発生を防止する。 この場合に概定点のに扱いては、立上りの特定に から、5 a Sとなるから、それ以上のパルス幅に が用いられるから関盟はない。又称2 はない が用いられるから関盟はない。又称2 はない を設定なるがある。以ばない。又称2 はない が用いるように、近上のはない。又称2 はない でも違点の設証をルだ対する者込みを行うことが 可能となる。

\*\*\* アクティブマトリクス型技器表示信置に続ける

三一百天 (建鐵鐵原金厂用一中日日

TFT等のスイッチング素子のゲート容量C 8 やオンからオフに多行する時の等個抵抗R では、スイッチング素子の構成に応じて異なるものであるが、その時定級R t・C 8 よりも、ドライバ 6 から最も近い滋温セルのスイッチング素子のオンからオフに移行させるパルス 望圧の立下りの時定数でを大きくずるもので、その為の手殴りとしては、流述の実施測以外に各種の構成を採用することができるものである。

以上級明したように、本発明は、スキャンパスラインG 1~ Caに印加するスキャンパルスの少なくとも立下り時定数でを、TP T等のスイッチング素子2のオンからオフに移行する過程の時定数R t. Cs以上に設定する流流や容量等による時定数手段1を設けたものであり、近点の被品セル電圧と適点の被品セル電圧との変化分をほぼ同じくすることができることにより、輝度むらの発生を防止して、表示品質を向上することができる利点がある。

#### 4 図画の簡単な説明

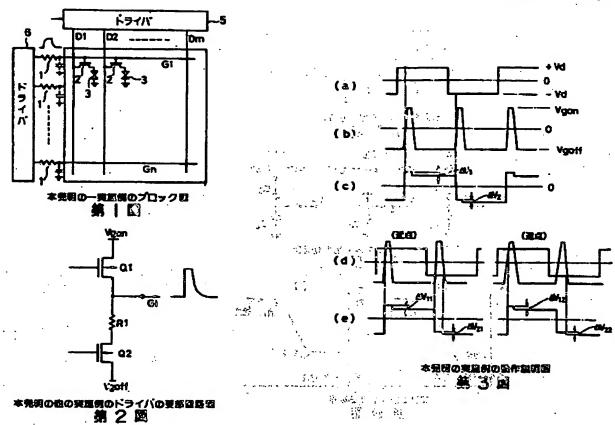
第1図は本発明の一変施例のプロック図、第2 図は本発明の他の変質例のドライバの更都問題 第3図は本発明の実施例の時件説明図、第4図 以スキャンベスラインの等値選路、第5図は時定 数曲類図、第6図は従来側の動作説明図、第7図 は被品セルの接続構成製明図、第8図(A)。( B)。(C)はTPTのオン、オフによる動作説 明図、第9図(A)。(B)は輝度むら発生の製 明図である。

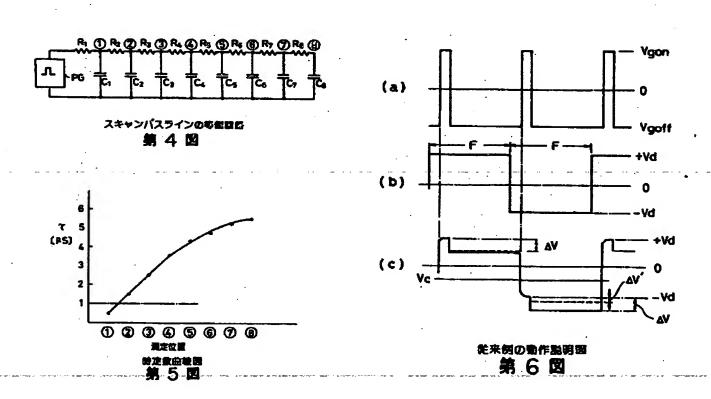
1 は時定数手段、2 はスイッチング者子、3 は 被晶セル、5.6 はドライバ、D 1 ~ D m はデー タバスライン、G 1 ~ G m はスキャンパスライン である。

> 特許出職人 富士遺株式会社 代理人弁理士 柏 谷 昭 町 代理人弁理士 波 邊 弘 一

110

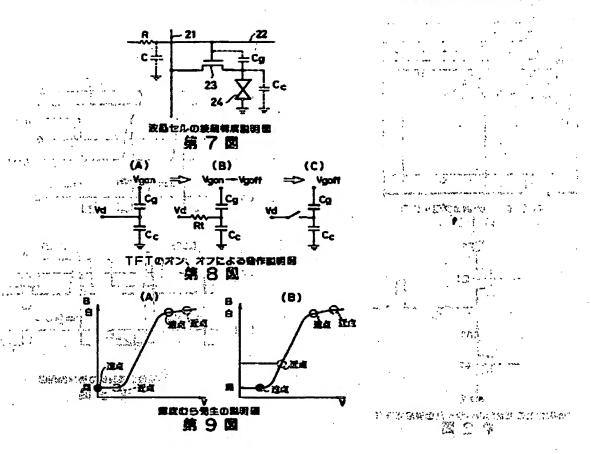
# 特開昭63-198022 (6)





#### 特別昭63-198022 (ア)

Statement of Williams



Tanko Visito III — arabir — e e e e e e e e

Participation of Turbs (The Arthur) To feel the Court Beach as Black (The jir ole millere baro i Golus Mosto. In oleh May

keb rango timba tannag sabna ut nyaya or paint was to achieve at the malayer everying the time. lembers so there is leading to blefill etc. In a rianupers liasis a palauberan liai an is secretari for a common belocal ategor of the Accel Time er la caracte l'atra de la calcula de la calcula d'accident de la calcula d'accident de la calcula d and it is having a movedom which is the tyes had a or ain E. langis note evaluation, color of a mountaindering of the color Curing Montague Best Council (A Council Beautiful Beauti whose it Councilled a manage beaturation and a majority The garante solution of the applied voltage (Sur g tivad michevely elineg a vac lutiv in imeyol yetishici a, in 1919 o you gailly relieve - Elizable of the Control of States and Control of the Control in the control of the काला कार्य के इस्केट प्रकारिक कार्य के कार्य के अपने कार्य कार्य के अपने कार्य के अपने कार्य के अपने कार्य की NERTH WORLD CO. CONTRACTOR Committee of the

Applicated office or stone and the state of the second



ប្រាស់កាស់ស្រាប់ប្រធាន ស៊ើ ស៊ីថា បានក

Trustine is a recision to a nearing we give you is

erff is formation of diplication in is once to a conanitoxid gap to netbodyn for the aneth

Indianate to

to apparage not reconstruited

i acre

智 恢复 经工作 化加油 化氯 电电子电子

THE STEE HISTORY SERVED SE

. . . . .

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGÉ CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)